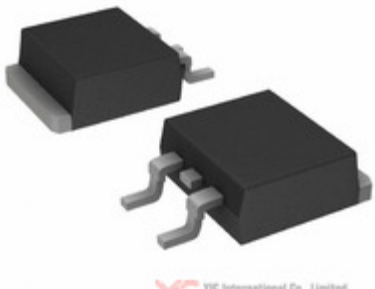








	<h2 style="color: #E67E22;">SQD40N06-25L-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SQD40N06-25L-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 30A TO252
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 10000 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	SQD40N06-25L-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 30A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10000 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 30A (Tc) Surface Mount TO-252, (D-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	-
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1800pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SQD40N06-25L-GE3 ist neu im Original, Suche SQD40N06-25L-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQD40N06-25L-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQD40N06-25L-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SQD40N06-14L VISHAY SQD40N06-14L VISHAY	 SQD40N10-25-GE3 V SQD40N10-25-GE3 V	 SQD40N06-25L-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 30A TO252	 SQD40N06-14L-GE3 V SQD40N06-14L-GE3 V
 SQD40N10-25_GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 40A TO252	 SQD40N10-25_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 40A TO252	 SQD40N06-14L_GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 40A	 SQD40N06-14L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 40A

heiße Teile

Mehr

⊕ SQD300AA100E	↔ SQD300AA120	⇒ SQD300AA60	D SQD300BA60	↗ SQD300H100
⊕ SQD30N05-20L	⊕ SQD30N05-20L-GE3	D SQD35JA140	⇒ SQD35JA160	↗ SQD35N05-26L-GE3
⊕ SQD35N05-26L-GE3	⊕ SQD400A60	⊕ SQD400A60N	↔ SQD400A60S	↗ SQD400A60S/
D SQD400AA-120	⊕ SQD400AA100	⊕ SQD400AA120	⊕ SQD400AA60	↗ SQD400BA60
⇒ SQD40N04-10A-GE3	↔ SQD40N06-14L	⊕ SQD40N06-14L-GE3	⊕ SQD40N06-14L_GE3	↗ SQD40N06-14L_GE3
↔ SQD40N06-25L-GE3	⇒ SQD40N10-25	D SQD40N10-25-GE3	⊕ SQD40P10-40L-GE3	⊕ SQD45N05-20L-GE3
⊕ SQD45N05-20L-GE3	D SQD45P03-12	⇒ SQD45P03-12-GE3	↔ SQD50A100	↗ SQD50A60
⊕ SQD50A90	⊕ SQD50AA100	↔ SQD50AB100	⇒ SQD50AB90	↗ SQD50B90
⊕ SQD50BA100	⊕ SQD50BB75	⊕ SQD50BB90	D SQD50CB100	↗ SQD50DB100
↔ SQD50N02-04-GE3	⊕ SQD50N03-06P-GE3	⊕ SQD50N03-09-GE3	⊕ SQD50N03-4M3	↗ SQD50N04-09H-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited